



特長

- 高周波、高電流耐量
- テーラップ構造の大容量シリーズ

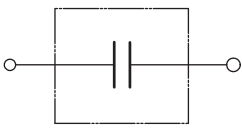
用途

- IGBT、IPM等半導体デバイスの保護(スナバ回路)
- スイッチング電源、インバータ/サーボ機器等



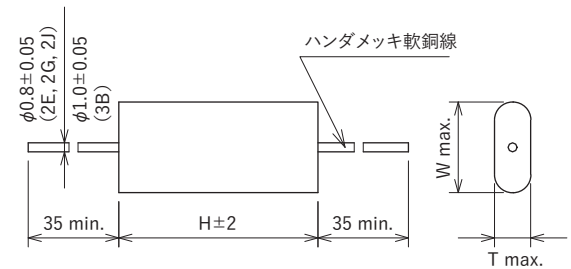
●型名構成

●回路図



C	1	N	P	2	E	2	2	5	K
シリーズ名				定格電圧	公称静電容量	静電容量許容差			
2E	250Vdc				容量(pF)を最初の2桁で表し、第3数字は続く0の数を表します。	J	±5%		
2G	400Vdc					K	±10%		
2J	630Vdc								
3B	1,250Vdc								

●外形寸法



※許容電流特性については別途お問い合わせ下さい。

単位: mm

定格電圧	型名	静電容量 μF	外形寸法 (mm)				誘電正接	試験電圧 (端子間)	絶縁抵抗 (端子間)
			W	H	T	φ d			
2E (250Vdc)	C1NP2E225□	2.2	20.0	44.0	8.0	0.8	0.001max. (at 1kHz)	定格電圧×1.75Vdc (2~5sec)	20000Ω・Fmin. (at 20°C, 100Vdc)
	C1NP2E275□	2.7	21.5	44.0	9.0	0.8			
	C1NP2E335□	3.3	22.0	44.0	10.5	0.8			
	C1NP2E395□	3.9	23.5	44.0	11.5	0.8			
	C1NP2E475□	4.7	25.0	44.0	13.0	0.8			
	C1NP2E565□	5.6	27.0	44.0	14.5	0.8			
	C1NP2E685□	6.8	28.5	44.0	16.5	0.8			
	C1NP2E825□	8.2	33.5	44.0	17.5	0.8			
	C1NP2E106□	10	34.5	44.0	19.5	0.8			
	C1NP2E126□	12	37.0	44.0	22.0	0.8			
2G (400Vdc)	C1NP2G125□	1.2	20.5	44.0	9.0	0.8			
	C1NP2G155□	1.5	22.0	44.0	10.5	0.8			
	C1NP2G185□	1.8	23.5	44.0	11.5	0.8			
	C1NP2G225□	2.2	25.0	44.0	13.0	0.8			
	C1NP2G275□	2.7	26.5	44.0	14.5	0.8			
	C1NP2G335□	3.3	28.5	44.0	16.5	0.8			
	C1NP2G395□	3.9	32.0	44.0	17.5	0.8			
	C1NP2G475□	4.7	34.5	44.0	19.0	0.8			
	C1NP2J824□	0.82	20.5	44.0	9.5	0.8			
	C1NP2J105□	1.0	21.5	44.0	10.0	0.8			
2J (630Vdc)	C1NP2J125□	1.2	23.0	44.0	11.5	0.8			
	C1NP2J155□	1.5	24.5	44.0	13.0	0.8			
	C1NP2J185□	1.8	26.5	44.0	14.5	0.8			
	C1NP2J225□	2.2	28.0	44.0	16.0	0.8			
	C1NP2J275□	2.7	30.5	44.0	17.5	0.8			
	C1NP2J335□	3.3	35.0	44.0	20.0	0.8			
	C1NP3B105□	1.0	30.0	60.0	20.5	1.0			
3B (1250Vdc)	C1NP3B125□	1.2	32.5	60.0	23.0	1.0			
	C1NP3B155□	1.5	35.5	60.0	26.0	1.0			
	C1NP3B185□	1.8	38.5	60.0	29.0	1.0			
	C1NP3B225□	2.2	38.0	70.0	28.5	1.0			
	C1NP3B275□	2.7	41.5	70.0	32.0	1.0			
	C1NP3B335□	3.3	45.5	70.0	36.0	1.0			
	C1NP3B395□	3.9	49.0	70.0	39.5	1.0			
	C1NP3B475□	4.7	53.0	70.0	44.0	1.0			

□: 静電容量許容差: J(±5%), K(±10%)

使用温度範囲: -40~+85°C